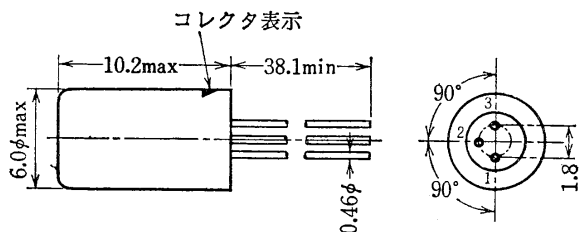


2SD75, 2SD75A

ゲルマニウム NPN 合金接合形
低周波小信号増幅用



1. エミッタ 2. ベース 3. コレクタ

■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

		2SD75	2SD75A
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	25	45 V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	25	45 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	12	12 V
コレクタ電流	I_C	100	100 mA
エミッタ電流	I_E	-100	-100 mA
許容コレクタ損失	P_C	150	150mW
接合部温度	T_j	85	85 °C
保存温度	T_{stg}	-55~+85	-55~+85 °C

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

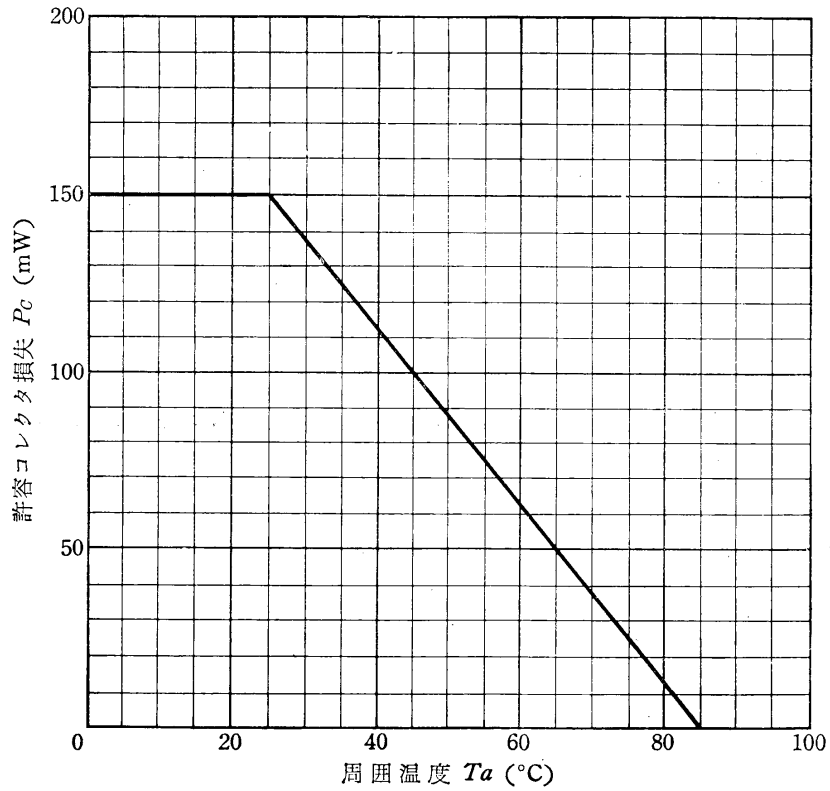
	2SD75			2SD75A		
	最小	標準	最大	最小	標準	最大
コレクタ遮断電流						
I_{CBO} ($V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$)	—	—	14	—	—	—
コレクタ遮断電流						
I_{CBO} ($V_{CB}=45\text{V}, I_E=0$)	—	—	—	—	—	25
小信号入力インピーダンス						
h_{ie} ($V_{CE}=6\text{V}, I_E=-1\text{mA}, f=270\text{c/s}$)	—	1260	—	—	1260	—
小信号電圧帰還率						
h_{re} (")	—	3.0	—	—	3.0	—
小信号電流増幅率*						
h_{fe} (")	—	40	—	—	40	—
遮断周波数						
f_{ab} ($V_{CB}=6\text{V}, I_E=-1\text{mA}$)	—	3	—	—	3	—
雑音指数						
NF ($V_{CE}=6\text{V}, I_E=-1\text{mA}, f=1\text{kc}, \Delta f=100\text{c/s}, R_g=500\Omega$)	—	6	—	—	6	—
電力利得						
PG ($V_{CE}=6\text{V}, I_E=-1\text{mA}, f=270\text{c/s}$)	エミッタ接地	—	45	—	45	—
	ベース接地	—	35	—	35	—
	コレクタ接地	—	16	—	16	—

* 2SD75, 75A は h_{fe} の値により下記のように3区分し現品にそれぞれ ㉠, ㉡, ㉢と表示してあります。

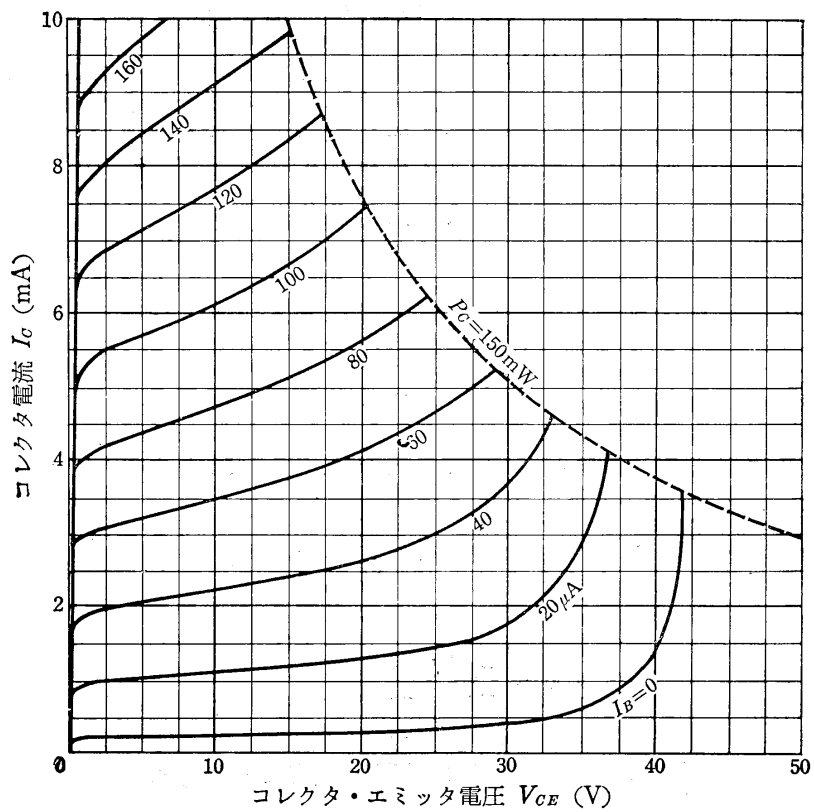
	㉠	㉡	㉢
h_{fe}	30	40	55

2SD75, 2SD75A

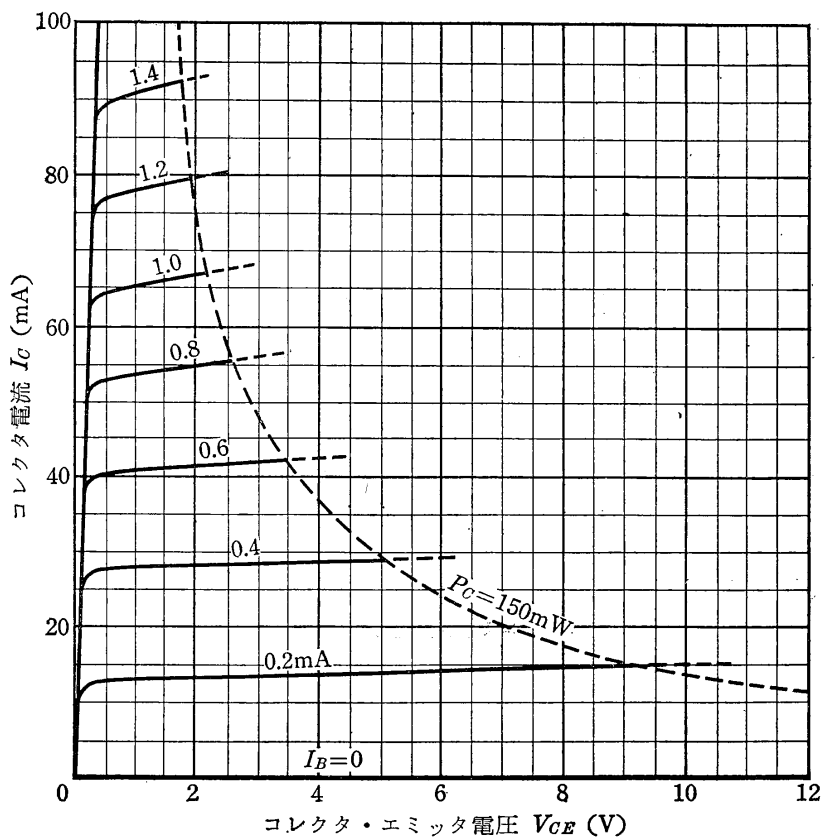
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



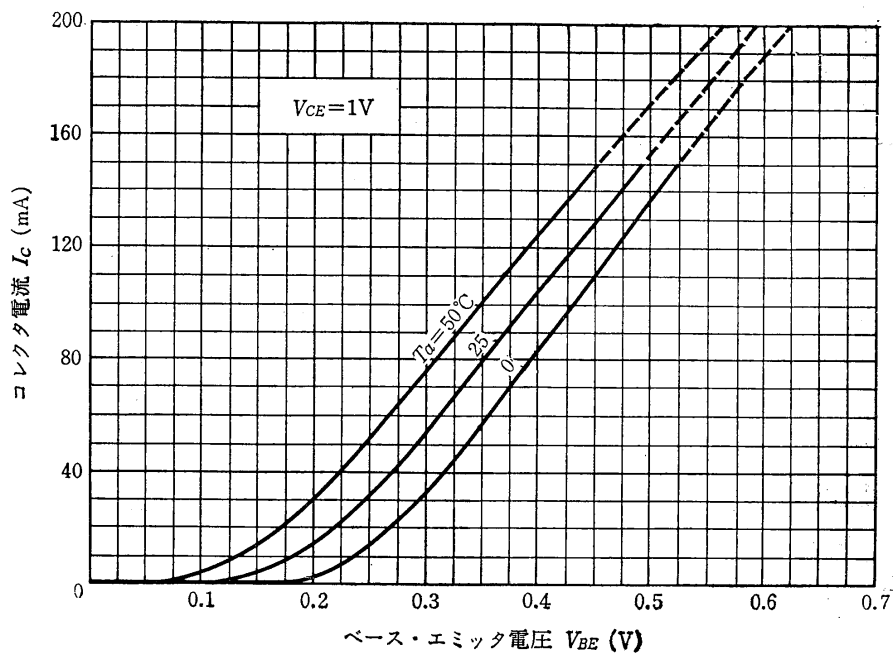
エミッタ接地出力静特性 (1)



エミッタ接地出力静特性 (2)

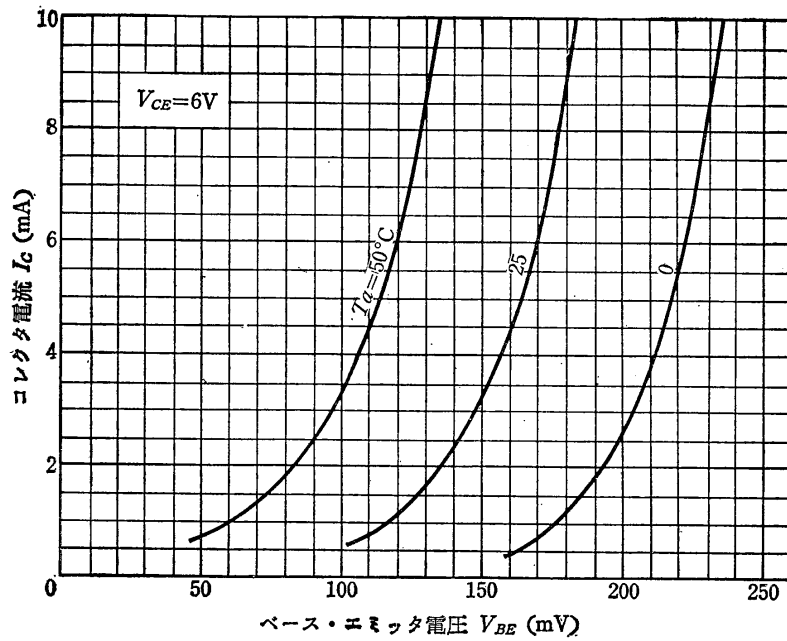


エミッタ接地伝達静特性 (1)

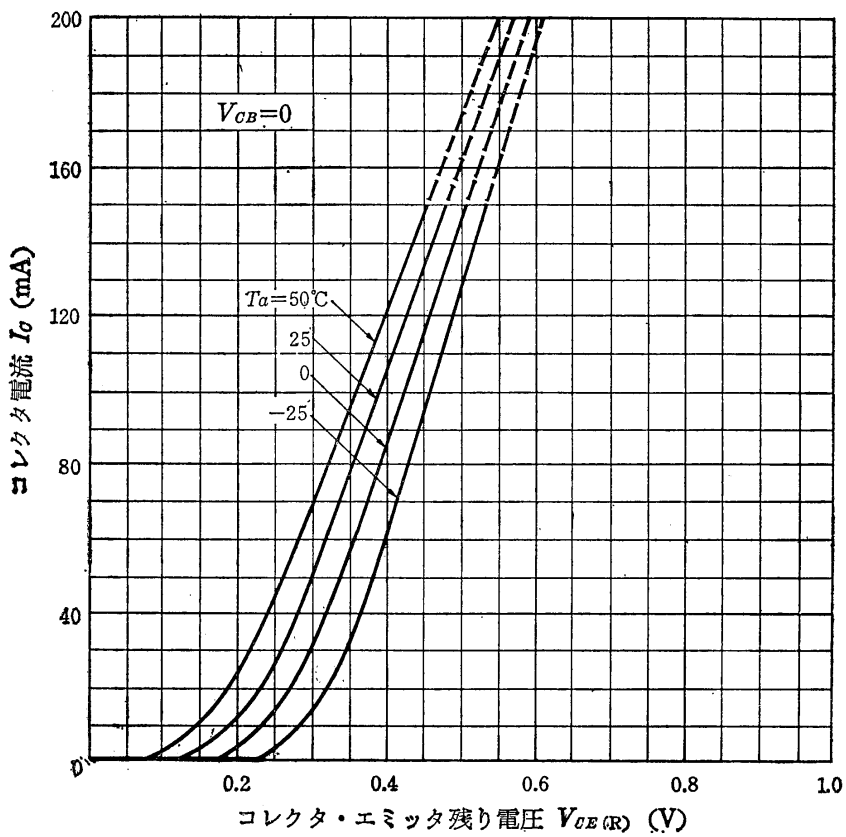


2SD75, 2SD75A

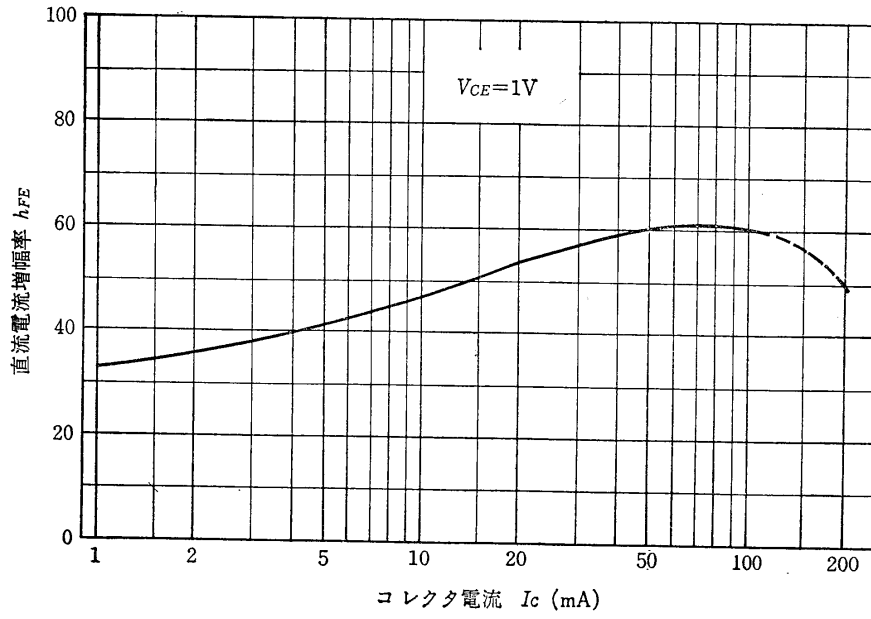
エミッタ接地伝達静特性 (2)



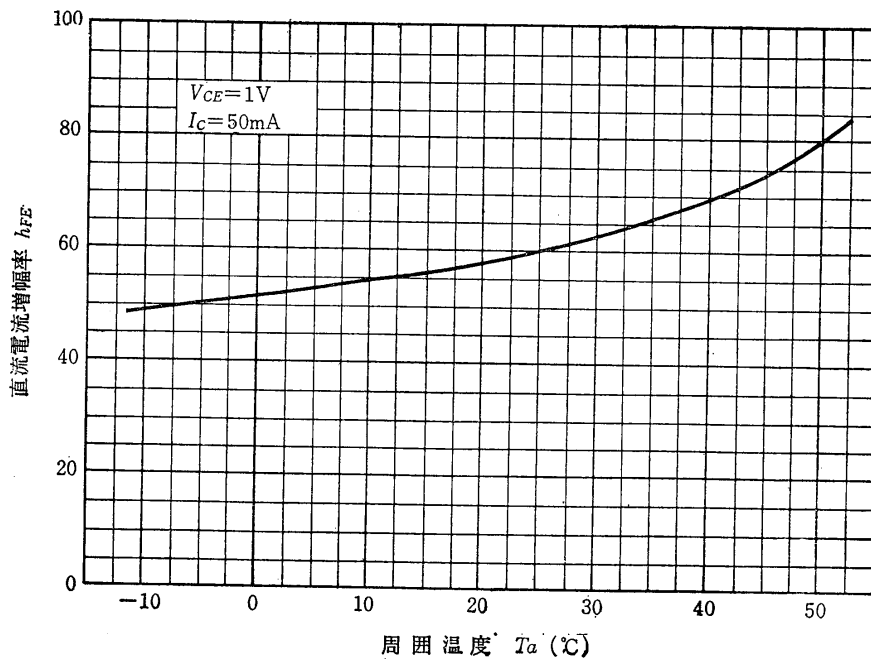
コレクタ電流対コレクタ・エミッタ残り電圧特性



直流電流増幅率対コレクタ電流特性

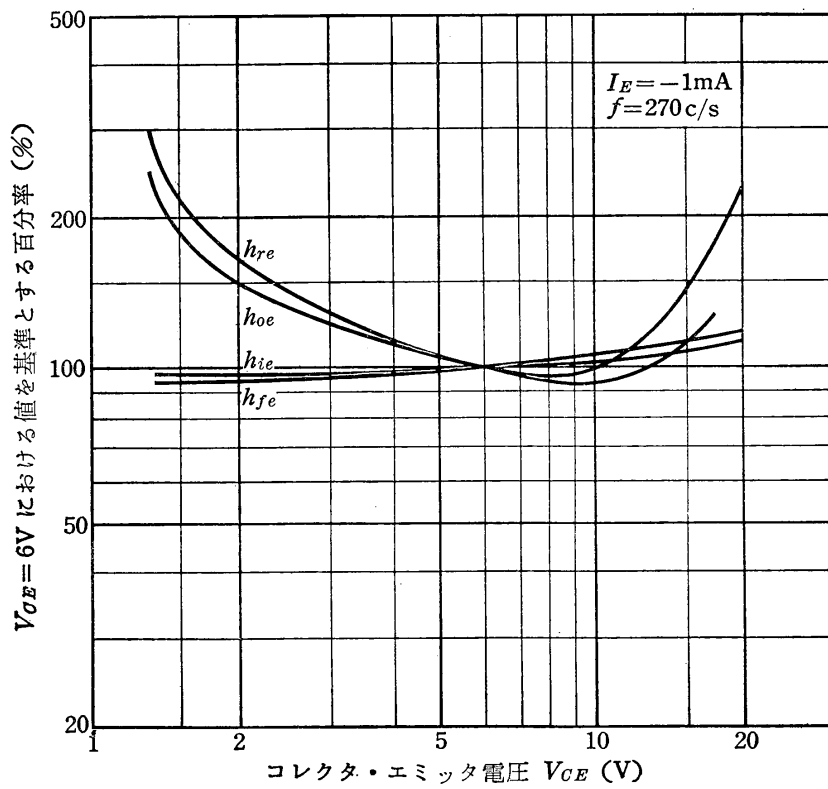


直流電流増幅率対周囲温度特性

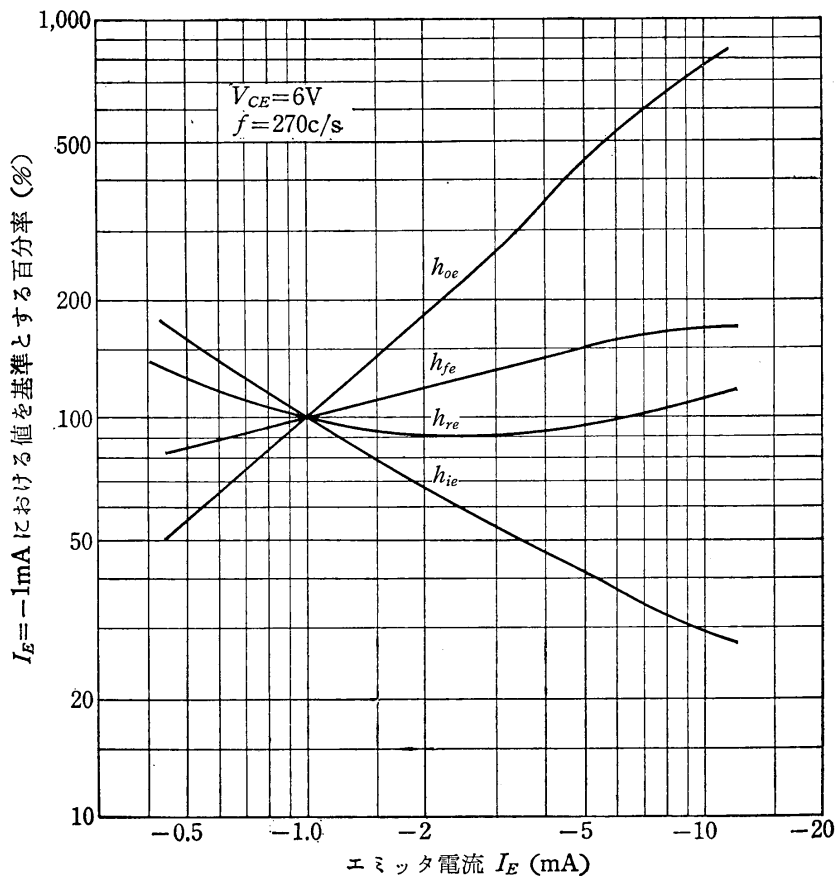


2SD75, 2SD75A

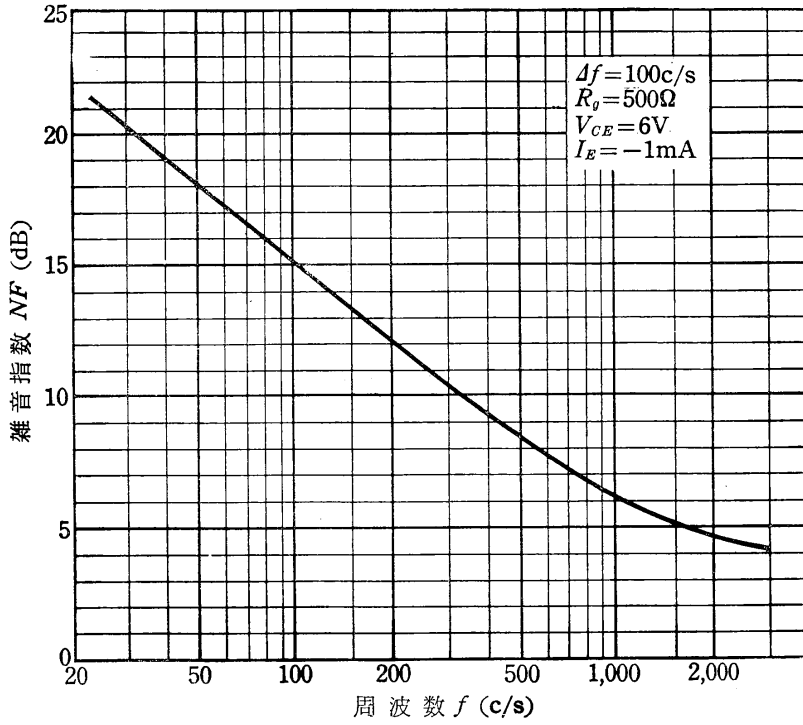
h 定数対コレクタ・エミッタ電圧特性



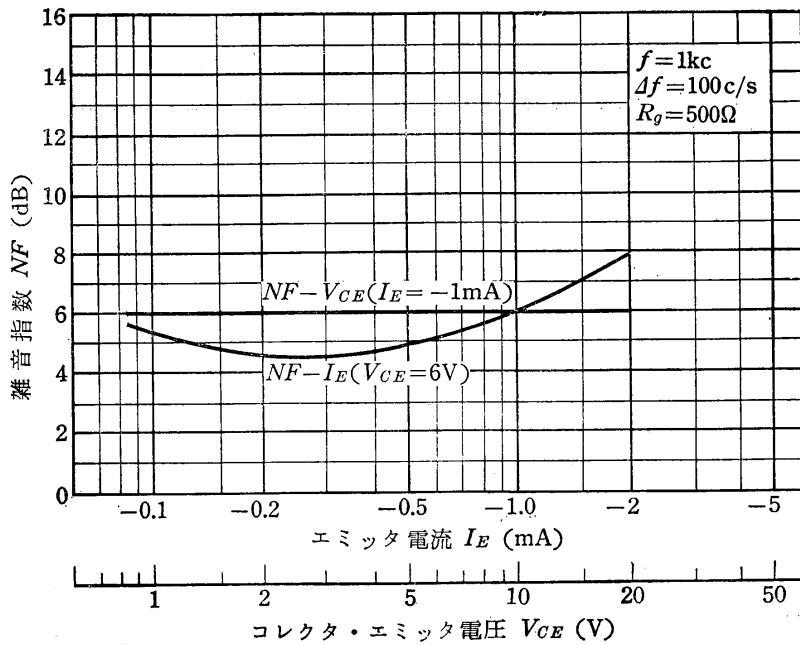
h 定数対エミッタ電流特性



雑音指数対周波数特性

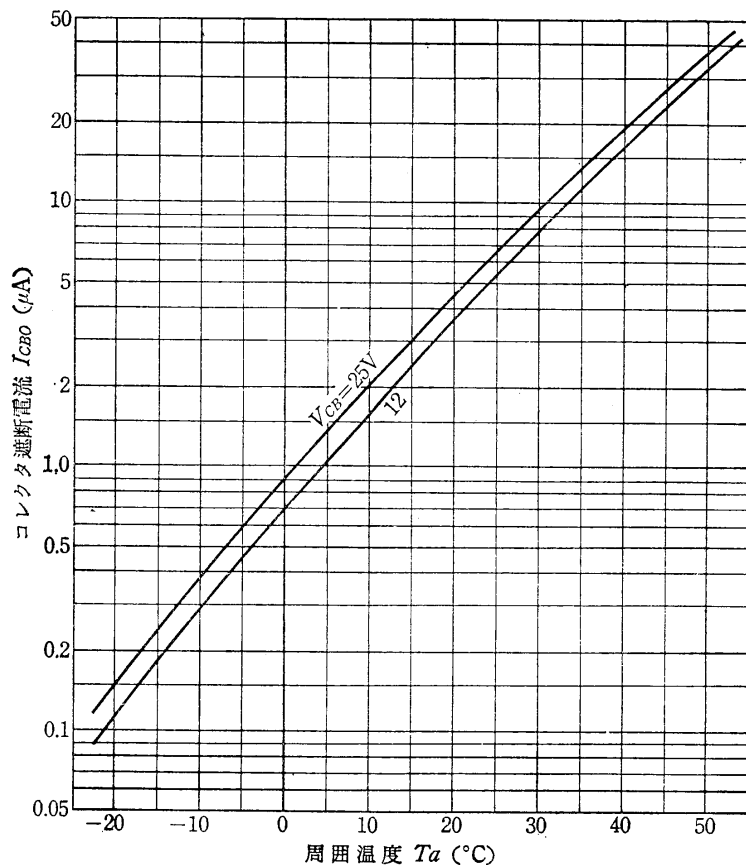


雑音指数対電圧電流特性

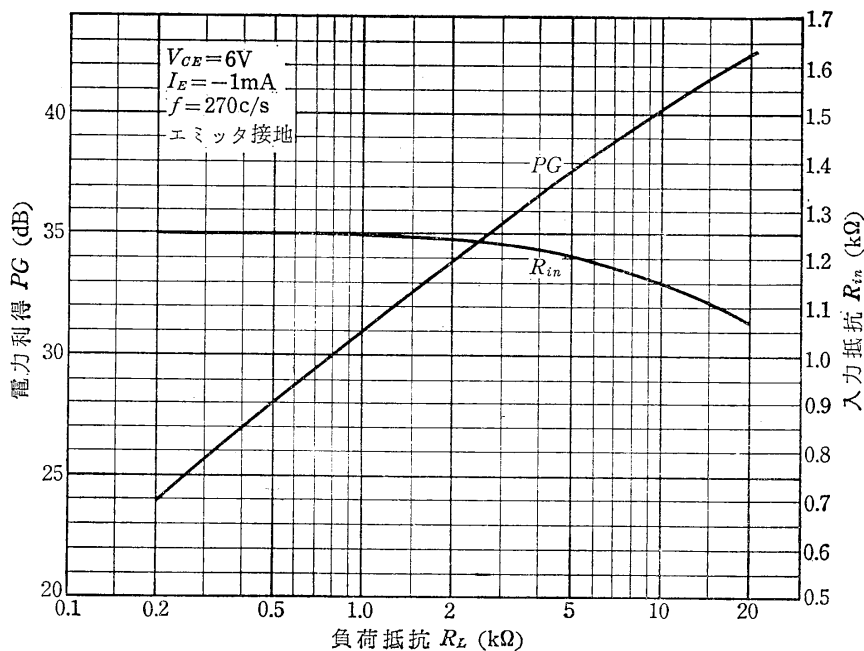


2SD75, 2SD75A

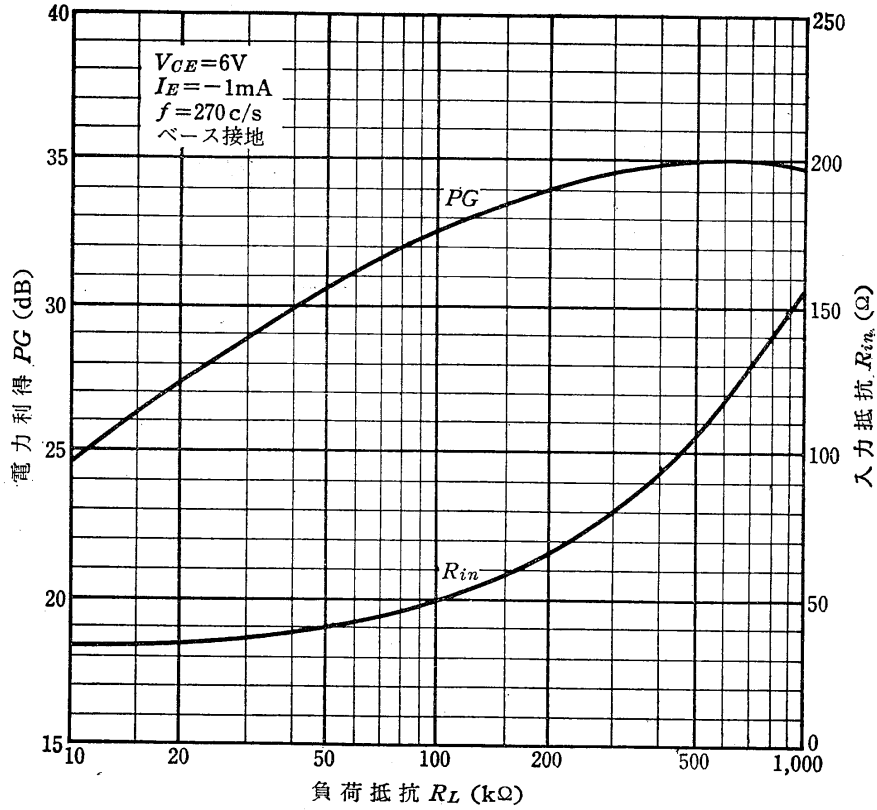
コレクタ遮断電流対周囲温度特性



電力利得・入力抵抗対負荷抵抗特性 (エミッタ接地)



電力利得・入力抵抗対負荷抵抗特性（ベース接地）



電力利得・入力抵抗対負荷抵抗特性（コレクタ接地）

